

粒子束及加速器技术

陶瓷真空室镀膜工艺改进及脉冲磁场时间特性测量

[尚雷](#) [王相綦](#) [蒋道满](#) [王琳](#) [赵枫](#) [冯光耀](#)

(中国科学技术大学 国家同步辐射实验室, 安徽 合肥 230029)

摘要: 介绍了合肥光源二期工程注入段陶瓷真空室的改进情况, 采用新的镀膜技术, 大大改善了脉冲磁场的延时特性, 减少了储存环注入时的轨道扰动, 提高了注入束流累积效率。改进了原来的点线圈磁场测量方法, 采用带有积分电路及抗干扰措施的双线圈测量装置测量了真空室内的脉冲磁场延时特性, 使脉冲磁场延时误差测量的分辨率达到ns量级, 给出了测量结果。

关键词: [陶瓷真空室](#) [镀膜](#) [脉冲磁场](#) [延时](#) [扰动](#) [注入效率](#)

通信作者:

相关文章([陶瓷真空室](#)):

[合肥光源镀膜陶瓷真空室纵向阻抗计算](#)
[陶瓷真空室镀膜工艺改进及脉冲磁场时间特性测量](#)

[\[PDF全文\]](#)

[\[HTML摘要\]](#)

[发表评论](#)

[查看评论](#)